

# The Raw Silicon Wafer硅片

## 3-inch mono crystal silicon N-type light doped wafer

### 3寸单晶硅N型轻掺硅片

| 电阻率 $\Omega\cdot\text{CM}$ | 厚度 $\mu\text{m}$ | 晶向    | 寿命 $\mu\text{s}$ | 外径 $\text{mm}$ | 掺杂剂 | 形态  |     |     |     | 电阻率径向不均匀性 |
|----------------------------|------------------|-------|------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                            |                  |       |                  |                |     | 线切片 | 研磨片 | 倒角片 | 定位片 |           |
| 5-10                       | 200-350          | <111> | >100             | 76.2 $\pm$ 0.3 | 磷   | √   | √   | √   | √   | ≤20%      |
| 10-15                      | 200-350          | <111> | >100             | 76.2 $\pm$ 0.3 | 磷   | √   | √   | √   | √   | ≤20%      |
| 15-20                      | 200-350          | <111> | >100             | 76.2 $\pm$ 0.3 | 磷   | √   | √   | √   | √   | ≤20%      |
| 20-25                      | 200-350          | <111> | >100             | 76.2 $\pm$ 0.3 | 磷   | √   | √   | √   | √   | ≤20%      |
| 25-30                      | 200-350          | <111> | >100             | 76.2 $\pm$ 0.3 | 磷   | √   | √   | √   | √   | ≤20%      |
| 30-35                      | 200-350          | <111> | >100             | 76.2 $\pm$ 0.3 | 磷   | √   | √   | √   | √   | ≤20%      |
| 35-40                      | 200-350          | <111> | >100             | 76.2 $\pm$ 0.3 | 磷   | √   | √   | √   | √   | ≤20%      |
| 40-45                      | 200-350          | <111> | >100             | 76.2 $\pm$ 0.3 | 磷   | √   | √   | √   | √   | ≤20%      |
| 45-50                      | 200-350          | <111> | >100             | 76.2 $\pm$ 0.3 | 磷   | √   | √   | √   | √   | ≤20%      |
| 50-55                      | 200-350          | <111> | >100             | 76.2 $\pm$ 0.3 | 磷   | √   | √   | √   | √   | ≤20%      |

## 4-inch mono crystal silicon N-type light doped wafer

### 4寸单晶硅N型轻掺硅片

| 电阻率 $\Omega\cdot\text{CM}$ | 厚度 $\mu\text{m}$ | 晶向    | 寿命 $\mu\text{s}$ | 外径 $\text{mm}$  | 掺杂剂 | 形态  |     |     |     | 电阻率径向不均匀性 |
|----------------------------|------------------|-------|------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                            |                  |       |                  |                 |     | 线切片 | 研磨片 | 倒角片 | 定位片 |           |
| 5-10                       | 200-350          | <111> | >100             | 101.6 $\pm$ 0.3 | 磷   | √   | √   | √   | √   | ≤20%      |
| 10-15                      | 200-350          | <111> | >100             | 101.6 $\pm$ 0.3 | 磷   | √   | √   | √   | √   | ≤20%      |
| 15-20                      | 200-350          | <111> | >100             | 101.6 $\pm$ 0.3 | 磷   | √   | √   | √   | √   | ≤20%      |
| 20-25                      | 200-350          | <111> | >100             | 101.6 $\pm$ 0.3 | 磷   | √   | √   | √   | √   | ≤20%      |
| 25-30                      | 200-350          | <111> | >100             | 101.6 $\pm$ 0.3 | 磷   | √   | √   | √   | √   | ≤20%      |
| 30-35                      | 200-350          | <111> | >100             | 101.6 $\pm$ 0.3 | 磷   | √   | √   | √   | √   | ≤20%      |
| 35-40                      | 200-350          | <111> | >100             | 101.6 $\pm$ 0.3 | 磷   | √   | √   | √   | √   | ≤20%      |
| 40-45                      | 200-350          | <111> | >100             | 101.6 $\pm$ 0.3 | 磷   | √   | √   | √   | √   | ≤20%      |
| 45-50                      | 200-350          | <111> | >100             | 101.6 $\pm$ 0.3 | 磷   | √   | √   | √   | √   | ≤20%      |
| 50-55                      | 200-350          | <111> | >100             | 101.6 $\pm$ 0.3 | 磷   | √   | √   | √   | √   | ≤20%      |

## 3-inch mono crystal silicon heavy doped wafer

### 3寸单晶硅重掺硅片

| 电阻率 $\Omega\cdot\text{CM}$ | 厚度 $\mu\text{m}$ | 晶向    | 型号  | 外径 $\text{mm}$ | 掺杂剂 | 形态  |     |     |     | 电阻率径向不均匀性 |
|----------------------------|------------------|-------|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                            |                  |       |     |                |     | 线切片 | 研磨片 | 倒角片 | 定位片 |           |
| 0.003-0.005                | 200-350          | <111> | N/P | 76.2 $\pm$ 0.3 | 磷/硼 | /   | √   | √   | √   | /         |
| 0.005-0.008                | 200-350          | <111> | N/P | 76.2 $\pm$ 0.3 | 磷/硼 | /   | √   | √   | √   | /         |
| 0.02-0.03                  | 200-350          | <111> | N/P | 76.2 $\pm$ 0.3 | 磷/硼 | /   | √   | √   | √   | /         |

## 4 inch monocrystal silicon heavy doped wafer

### 4寸单晶硅重掺硅片

| 电阻率 $\Omega\cdot\text{CM}$ | 厚度 $\mu\text{m}$ | 晶向    | 型号  | 外径 $\text{mm}$  | 掺杂剂 | 形态  |     |     |     | 电阻率径向不均匀性 |
|----------------------------|------------------|-------|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|                            |                  |       |     |                 |     | 线切片 | 研磨片 | 倒角片 | 定位片 |           |
| 0.003-0.005                | 200-350          | <111> | N/P | 101.6 $\pm$ 0.3 | 磷/硼 | /   | √   | √   | √   | /         |
| 0.005-0.008                | 200-350          | <111> | N/P | 101.6 $\pm$ 0.3 | 磷/硼 | /   | √   | √   | √   | /         |
| 0.02-0.03                  | 200-350          | <111> | N/P | 101.6 $\pm$ 0.3 | 磷/硼 | /   | √   | √   | √   | /         |